

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 5 月 25 日 (2006.5.25)

【公開番号】特開 2004-128446 (P2004-128446A)

【公開日】平成 16 年 4 月 22 日 (2004.4.22)

【年通号数】公開・登録公報 2004-016

【出願番号】特願 2003-86898 (P2003-86898)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

G 1 1 C 16/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/10 3 2 1

G 1 1 C 17/00 6 2 1 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 3 月 24 日 (2006.3.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

前記第 2 の導電ゲートと前記第 3 の半導体領域との電位関係の第 1 の組み合わせにより、前記第 3 の半導体領域から前記第 2 のチャネル形成半導体薄膜部分を通して第 1 のチャネル形成半導体薄膜部分へ逆導電形のキャリア 2 を注入して、前記第 1 のチャネル形成半導体薄膜部分の前記第 1 の導電ゲートから見た第 1 の導電形のチャネルのゲート閾値電圧を第 1 の値 V_{th11} に変化させる。本発明ではこの動作を「書き込み」と呼ぶ。